

систем, синтезированы органические сверхпроводники и магнитные сверхпроводники, однако до 1986 макс. критич. темп-ра наблюдалась у сплава  $Nb_3Ge$  ( $T_c \approx 23$  К). В 1986 И. Г. Беднорцем (J. G. Bednorz) и К. А. Мюллером (K. A. Müller) был открыт новый класс металлоксидных высокотемпературных сверхпроводников (ВТСП) (см. *Оксидные высокотемпературные сверхпроводники*), критич. темп-ра к-рых в течение двух последующих лет была «поднята» от 30—35 К до 120—125 К. Эти сверхпроводники интенсивно изучаются, ведутся поиски новых, улучшаются технол. свойства существующих, на основе к-рых уже создаются нек-рые приборы.

Важным достижением в области С. стало открытие в 1962 Джозефсона эффекта туннелирования куперовских пар между двумя сверхпроводниками через тонкую диэлектрич. прослойку. Это явление легло в основу новой области применения сверхпроводников (см. *Слабая сверхпроводимость, Криоэлектронные приборы*).

**Природа сверхпроводимости.** Явление С. обусловлено возникновением корреляции между электронами, в результате к-кой они образуют куперовские пары, подчиняющиеся бозевской статистике, а электронная жидкость приобретает свойство сверхтекучести. В ф-онной модели С. спаривание электронов происходит в результате специфического, связанного с наличием кристаллич. решётки фононного притяжения. Даже при абл. нуле темп-ра совершает колебания (см. *Нулевые колебания, Динамика кристаллической решётки*). Эл.-статич. взаимодействие электрона с ионами решётки изменяет характер этих колебаний, что приводит к появлению дополнит. силы притяжения, действующей на др. электрон. Это притяжение можно рассматривать как обмен виртуальными фононами между электронами. Такое притяжение связывает электроны в узком слое вблизи границы ферми-поверхности. Толщина этого слоя в энергетич. масштабе определяется макс. энергией фонона  $\hbar\omega_D \sim \hbar v_s/a$ , где  $\omega_D$  — дебаевская частота,  $v_s$  — скорость звука,  $a$  — постоянная решётки (см. *Дебая температура*); в импульсном пространстве это соответствует слою толщиной  $\Delta p \sim \hbar\omega_D/v_F$ , где  $v_F$  — скорость электронов вблизи поверхности Ферми. Соотношение неопределённостей даёт характерный масштаб области фононного взаимодействия в координатном пространстве:

$$\Delta r \sim \hbar/\Delta p \sim v_F/\omega_D \sim v_F a/v_s \sim (M/m)^{1/2} a,$$

где  $M$  — масса иона остова,  $m$  — масса электрона. Величина  $\Delta r \sim 10^{-6} \div 10^{-5}$  см, т. е. фононное притяжение оказывается дальнодействующим (по сравнению с межатомными расстояниями). Кулоновское отталкивание электронов обычно несколько превышает по величине фононное притяжение, но благодаря экранированию на межатомных расстояниях оно эффективно ослабляется и фононное притяжение может преобладать, объединяя электроны в пары. Сравнительно небольшая энергия связи куперовской пары оказывается существенно меньше кинетической энергии электронов, поэтому, согласно квантовой механике, связанные состояния не должны были бы возникнуть. Однако в данном случае речь идёт об образовании пар не из свободных изолиров. электронов в трёхмерном пространстве, а из квазичастиц ферми-жидкости при заполненной большой поверхности Ферми. Это приводит к фактич. замене трёхмерной задачи на одномерную, где связанные состояния возникают при сколь угодно слабом притяжении.

В модели БКШ спариваются электроны с противоположными импульсами  $p$  и  $-p$  (полный импульс куперовской пары равен 0). Орбитальный момент и суммарный спин пары также равны 0. Теоретически при нек-рых нефононных механизмах С. возможно спаривание электронов и с неионовым орбитальным моментом. По-видимому, спаривание в такое состояние осущ-

ществляется в сверхпроводниках с тяжёлыми фермионами (напр.,  $CeCu_2Si_2$ ,  $CeCu_6$ ,  $UB_{13}$ ,  $CeAl_3$ ).

В сверхпроводнике при темп-ре  $T < T_c$  часть электронов, объединённых в куперовские пары, образует базе-конденсат (см. *Бозе — Эйнштейна конденсация*). Все электроны, находящиеся в базе-конденсате, описываются единой когерентной волновой ф-цией  $\Psi$ . Остальные электроны пребывают в возбуждённых и конденсатных состояниях (фермиевские квазичастицы), причём их энергетич. спектр перестраивается по сравнению со спектром электронов в нормальном металле. В изотропной модели БКШ зависимость энергии электронов  $\varepsilon$  от импульса  $p$  в сверхпроводнике имеет вид ( $p_F$  — ферми-импульс):

$$\varepsilon(p) = \sqrt{\Delta^2 + v_F^2(p - p_F)^2}.$$

Т. о., вблизи уровня Ферми (рис. 1) в спектре возникает энергетическая щель  $\Delta$ . Для

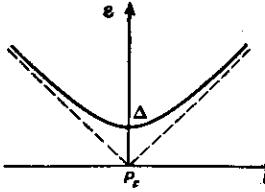


Рис. 1. Перестройка энергетического спектра электронов в сверхпроводнике (сплошная линия) по сравнению с нормальным металлом (пунктир).

того чтобы возбудить электронную систему с таким спектром, необходимо разорвать хотя бы одну куперовскую пару. Поскольку при этом образуются два электрона, то на каждый из них приходится энергия не меньшая  $\Delta$ , так что  $2\Delta$  имеет смысл энергии связи куперовской пары. Величина щели существенно зависит

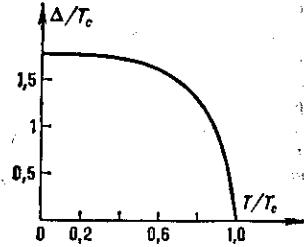


Рис. 2. Температурная зависимость энергетической щели в модели БКШ.

сит от темп-ры (рис. 2), при  $T_c = T \ll T_c$  она ведёт себя как  $\Delta(0)/k = 3,06V T_c(T_c - T)$ , а при  $T = 0$  достигает макс. значения  $\Delta(0)/k \approx 1,76T_c$ , причём

$$\Delta(0) = \hbar\omega_D \exp(-2/\rho g), \quad (2)$$

где  $\rho = m_F/2\pi^2\hbar^3$  — плотность одноэлектронных состояний вблизи поверхности Ферми,  $g$  — эф. константа межэлектронного притяжения.

В модели БКШ связь между электронами предполагается слабой ( $\rho g \ll 1$ ) и критич. темп-ра оказывается малой по сравнению с характерными фононными частотами ( $kT_c \ll \hbar\omega_D$ ). Однако для ряда веществ (напр., Pb) это условие не выполняется и параметр  $\rho g \sim 1$  (сильная связь). В литературе обсуждается даже приближение  $\rho g \gg 1$ . Сверхпроводники с сильной связью между электронами описываются т. н. уравнениями Элиашберга (Г. М. Элиашберг, 1968), из к-рых видно, что на величину  $T_c$  не возникает никаких принципиальных ограничений.

Наличие щели в спектре электронов приводит к экспоненц. зависимости  $\sim \exp(-\Delta(0)/kT)$  в области низких темп-р всех величин, определяющихся числом этих электронов (напр., электронной теплоёмкости и теплопроводности, коэффициентов поглощения звука и низкочастотного [ $\hbar\omega \ll \Delta(0)$ ] эл.-магн. излучения).

Вдали от ферми-уровня ( $|v_F|p - p_F| \gg \Delta$ ) выражение (1) описывает энергетич. спектр электронов нормаль-